






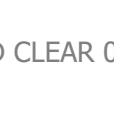
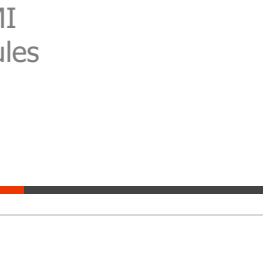
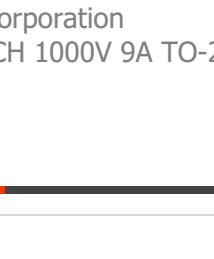
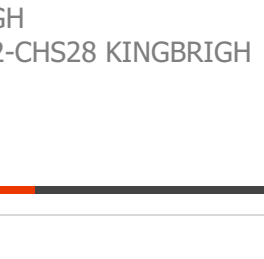




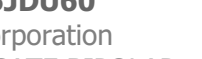

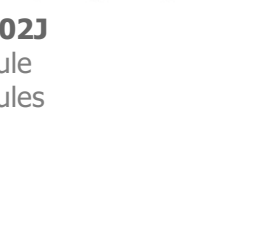
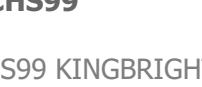
	<h2 style="color: red;">APT9M100B</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	APT9M100B
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 1000V 9A TO-247
Datenblätter:	1.APT9M100B.pdf	
	2.APT9M100B.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 6 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	APT9M100B
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	MOSFET N-CH 1000V 9A TO-247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	6 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 1mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247 [B]
Serie	POWER MOS 8™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	335W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2605pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	80nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1000V (1kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)

APT9M100B Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APT9M100B-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APT9M100B Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ APT9M100B E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>APT9M100B Microsemi</p>	 <p>APT97H50J MICROSEMI IGBT Modules</p>	 <p>APT9F100B Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 9A TO-247</p>	 <p>APT9M100B Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 9A TO-247</p>
 <p>APT9M100B Kingbright LED GREEN/RED CLEAR 0605 SMD</p>	 <p>APT97H50J MICROSEMI IGBT Modules</p>	 <p>APT9F100B Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 9A TO-247</p>	 <p>APT9M100B Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 9A TO-247</p>
 <p>APT95GR65JDU60 Microsemi Corporation INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTO</p>	 <p>APT97N65LC6 Microsemi Corporation MOSFET N-CH 650V 97A TO-264</p>	 <p>APTAPL502J IGBT Module IGBT Modules</p>	 <p>APT9M100B Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 9A TO-247</p>
 <p>APT95GR65JDU60 Microsemi Corporation INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTO</p>	 <p>APT97N65LC6 Microsemi Corporation MOSFET N-CH 650V 97A TO-264</p>	 <p>APTAPL502J IGBT Module IGBT Modules</p>	 <p>APT9M100B Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 9A TO-247</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

APT9M100B Microsemi	APT9M100B Datenblatt	APT9M100B-Datenblätter	APT9M100B PDF	Microsemi APT9M100B
APT9M100B Electronic	APT9M100B-Komponenten	APT9M100B-Verteiler	APT9M100B-Bild	APT9M100B-Teil
APT9M100B Preis	APT9M100B Hersteller	APT9M100B Bild	APT9M100B Aktie	APT9M100B Inventar
APT9M100B Neu	APT9M100B Original	APT9M100B garantiert	APT9M100B RFQ	APT9M100B Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited